

AIXTRON und Institut Lafayette entwickeln gemeinsam organische Depositionstechnologie OVPD weiter

AIXTRON Cluster-Anlage bei französischer Innovationsplattform erfolgreich installiert und für Kundentests verfügbar

Herzogenrath, 11. April 2016 – AIXTRON SE (FSE: AIXA; NASDAQ: AIXG), ein weltweit führender Hersteller von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, gibt bekannt, dass am Institut Lafayette eine neue OVPD (Organic Vapor Phase Deposition)-Anlage des Unternehmens zur Herstellung von 200x200 mm-Substraten erfolgreich installiert und getestet wurde. Die Installation der speziell angefertigten Anlage ist ein wichtiger Meilenstein und bedeutet für das Institut Lafayette, das auf dem internationalen Campus des Georgia Institute of Technology in Metz (Frankreich) angesiedelt ist, einen weiteren Schritt in Richtung seiner vollständigen Betriebsbereitschaft.

Die neu getestete OVPD-Clusteranlage und das zuvor schon in Betrieb genommene MOCVD-System sind am Institut Lafayette die beiden zentralen Möglichkeiten zur Herstellung von Halbleitern. Sie vervollständigen den bestehenden Anlagenpark, der alle Schlüsseltechnologien für die Herstellung, Prüfung und Prototypenentwicklung optoelektronischer Bauelemente abdeckt und in einem 500 m² großen Reinraum untergebracht ist.

AIXTRON's OEC-200 OVPD-Anlage umfasst acht STExS-Quellen (Short Thermal Exposure Source), die feste organisch-elektronische Materialien mittels eines schnellen und effizienten Prozesses in die Gasphase überführen und dabei die für bestimmte Materialien schädliche Hitzebelastung minimieren. Die Materialien in der Gasphase werden unter Nutzung von AIXTRON's Showerhead-Technologie in einem Reaktor unter niedrigen Vakuumbedingungen (Millibar-Bereich) durch ein kontrollierbares, heißes Trägergas auf die gekühlten Substrate abgeschieden. Die Taktung der mit dieser Technologie abgeschiedenen Materialien (bis zu 5 nm/s) lässt sich durch die Regelung des Materialflusses und der Materialkonzentration der heißen Gase im Showerhead anpassen. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle der Dicke und eine präzise Zusammensetzung der Filme. Die Reaktorkammer ist mit einer Vakuumkammer verbunden, die die Abscheidung von Metallelektroden für die Demonstration und Prüfung funktionierender Bauelemente erlaubt.

Mit seinen einzigartigen Eigenschaften verfügt das OVPD-Verfahren über das Potenzial die aktuell bestehenden Grenzen und Zweifel an der konventionellen Vakuumverdampfung (VTE) aufzuheben. Es könnte die zukunftsweisende Depositionstechnologie für die großflächige, kostensparende Produktion der zunehmend aufkommenden organischen Elektronikbauelemente sein, insbesondere der organischen Leuchtdioden (OLED) für Displays

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Corporate Communications

AIXTRON SE, Dornkaulstr. 2, 52134 Herzogenrath, Germany

PHONE +49 (2407) 9030-444 FAX +49 (2407) 9030-445

E-MAIL info@aixtron.de WEB www.aixtron.com

und Beleuchtung sowie organischer Photovoltaikbauelemente für die Erzeugung erneuerbarer Energie.

Die im OVPD-Prozess genutzte Showerhead-Technologie von AIXTRON besitzt den Vorteil, dass sie leicht skalierbar ist. Dies zeigen auch die jüngsten Testergebnisse der neuen Gen8-Demonstrationsanlage, die am Hauptsitz von AIXTRON in Herzogenrath ihren Betrieb aufgenommen hat.

Mit seinem eigenen Team von Ingenieuren im Bereich der organischen Elektronik sowie einzigartigen F&E Produktions- und Testeinrichtungen, ist das Institut Lafayette für erste Tests mit potenziellen Kunden gut gerüstet. Das IL bekennt sich zur weiteren Validierung der OVPD als der zukunftsweisenden Depositionstechnologie der Wahl.

Unter Anerkennung ihrer sich ergänzenden Stärken und der langen Geschichte in der Entwicklung von Halbleitermaterialien und -bauelementen sowie der Bereitstellung von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, haben das Institut Lafayette und AIXTRON eine Partnerschaft vereinbart. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde am 8. April 2016 im Beisein von Thierry Mandon, französischer Minister für Bildung und Forschung, und Marianne Therre-Mano, deutsche Konsulin in Straßburg, sowie von Stefan Kern, Referatsleiter Wissenschaft und Technologie an der deutschen Botschaft, in Metz unterzeichnet.

Abdallah Ougazzaden, Professor am Georgia Institute of Technology und Co-Präsident des Institut Lafayette, sagt: „Wir sind sehr zufrieden mit der umfassenden Unterstützung durch AIXTRON während der Inbetriebnahme, Installation und Testphase sowohl unserer MOCVD- als auch der OVPD-Anlage. Basierend auf dieser vertrauensvollen Zusammenarbeit, sind wir äußerst zuversichtlich unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen.“

„Wir freuen uns mit einer internationalen Forschungsinstitution wie dem Georgia Institute of Technology und dem Institut Lafayette zusammen zu arbeiten, um die Innovationen in der Optoelektronik sowie die Erforschung moderner Halbleitermaterialien mit unserer technisch führenden OVPD- und MOCVD-Produktionsanlagen zu unterstützen. Wir freuen uns auf eine lebhafteste Partnerschaft zur Weiterentwicklung zukunftsorientierter und wegweisender Halbleitertechnologien“, erklärt Martin Goetzeler, Vorstandsvorsitzender der AIXTRON SE.

Bernard Kippelen, Professor am Georgia Institute of Technology und Co-Präsident des Institut Lafayette, sagt: „Mit unserer OVPD-Anlage die operative Phase erreicht zu haben, ist ein wichtiger Meilenstein für unsere neu geschaffene Innovationsplattform. Unsere Teams und Partner auf beiden Seiten des Atlantiks haben unermüdlich daran gearbeitet diesen Punkt zu erreichen. Es ist ein weiterer Beleg für die Stärke der langjährigen Partnerschaft zwischen dem Georgia Tech, der Stadt Metz und Lothringens.“

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Corporate Communications

AIXTRON SE, Dornkaulstr. 2, 52134 Herzogenrath, Germany

PHONE +49 (2407) 9030-444 FAX +49 (2407) 9030-445

E-MAIL info@aixtron.de WEB www.aixtron.com

Über AIXTRON

Die AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.

Die OVPD®-Technologie wurde exklusiv von Universal Display Corporation (UDC), Ewing, N.J./USA, an AIXTRON zum Bau von Anlagen lizenziert. Sie basiert auf einer Erfindung von Professor Stephen R. Forrest et. al. an der Princeton University, USA, die wiederum exklusiv an UDC lizenziert wurde. AIXTRON und UDC haben gemeinsam einen OVPD®-Prototypen zur OLED-Herstellung entwickelt und qualifiziert.

Unsere eingetragenen Warenzeichen: AIXACT®, AIXTRON®, Atomic Level SolutionS®, Close Coupled Showerhead®, CRIUS®, Gas Foil Rotation®, OVPD®, Planetary Reactor®, PVPD®, TriJet®

Weitere Informationen über AIXTRON (FWB: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6; NASDAQ: AIXG, ISIN US0096061041) sind im Internet unter www.aixtron.com verfügbar.

Über Institut Lafayette

Das Institut Lafayette ist eine Innovationsplattform, die vor Kurzem auf dem Gelände des Technopole in Metz (Frankreich) in Partnerschaft mit dem Georgia Institute of Technology eingerichtet wurde. Sein Auftrag ist die Unterstützung öffentlicher Forschungsinstitutionen und privater Unternehmen durch die Bereitstellung von Technologietransfer- und Vermarktungsdienstleistungen, Zugang zu modernster technischer Infrastruktur und technischer Expertise im Bereich neuer Halbleitermaterialien, -komponenten und -bauelementen für opto-elektronische Anwendungen. Das IL ist eine private, französische Einrichtung, die teilweise durch die französische Regierung, lokale Regierungsbehörden und die FEDER Fonds der EU gefördert wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Finanz- und Ertragslage und Gewinnprognosen von AIXTRON im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Begriffe wie "können", "werden", "erwarten", "rechnen mit", "erwägen", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "fortdauern" und "schätzen", Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche Ausdrücke kennzeichnen diese zukunftsgerichteten Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen geben unsere gegenwärtigen Beurteilungen und Annahmen wieder und gelten vorbehaltlich bestehender Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten kein unangemessenes Vertrauen in die zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Trends können wesentlich von unseren zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Dies kann durch Faktoren verursacht werden, wie zum Beispiel die tatsächlich von AIXTRON erhaltenen Kundenaufträge, den Umfang der Marktnachfrage nach Depositionstechnologie, den Zeitpunkt der endgültigen Abnahme von Erzeugnissen durch die Kunden, das Finanzmarktklima und die Finanzierungsmöglichkeiten von AIXTRON, die allgemeinen Marktbedingungen für Depositionsanlagen, und das makroökonomische Umfeld, Stornierungen, Änderungen oder Verzögerungen bei Produktlieferungen, Beschränkungen der Produktionskapazität, lange Verkaufs- und Qualifizierungszyklen, Schwierigkeiten im Produktionsprozess, die allgemeine Entwicklung der Halbleiterindustrie, eine Verschärfung des Wettbewerbs, Wechselkursschwankungen, die Verfügbarkeit öffentlicher Mittel, Zinsschwankungen bzw. Änderung verfügbarer Zinskonditionen, Verzögerungen bei der Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte, eine Verschlechterung der allgemeinen Wirtschaftslage sowie durch alle anderen Faktoren, die AIXTRON in öffentlichen Berichten und Meldungen aufgeführt und bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereicht hat. In dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und haben Gültigkeit zum Zeitpunkt dieser Mitteilung. AIXTRON übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überprüfung zukunftsgerichteter Aussagen wegen neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen, soweit keine ausdrückliche rechtliche Verpflichtung besteht.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an

Corporate Communications

AIXTRON SE, Dornkaulstr. 2, 52134 Herzogenrath, Germany

PHONE +49 (2407) 9030-444 FAX +49 (2407) 9030-445

E-MAIL info@aixtron.de WEB www.aixtron.com